

■募集情報

募集番号	2026-9
部署名	先端 ICT デバイス研究開発推進センター
インターンシップ課題名	光・電波集積デバイスの半導体プロセス加工と最適化
インターンシップ内容の概要	当機構が研究開発を進めている光・電波集積デバイスの微細加工プロセスについて、材料や構造などの最適条件の探索を行う。インターンシップではクリーンルーム内での半導体微細加工装置を用いた作業を実体験し、デバイス構造の作製とその構造的・電氣的評価等を実施する。
課題に関する問い合わせ先	先端 ICT デバイス研究開発推進センター 山本直克 042-327-6982
応募条件	・ 対象：高専、大学、大学院 ・ 大学 3 年生以上
実施場所	小金井本部
実施期間	2027 年 1 月 6 日～2 月 22 日の間の期間
受入可能最大人数	3 名
選考課題	
備考	